

応用物理学会 第13回励起ナノプロセス研究会

テーマ：ワイドギャップ半導体の励起ナノプロセス

ワイドギャップ半導体は、IT、および省・創エネルギーに重要な材料として注目されています。その光物性発現への期待は大きく、種々の研究アプローチがとられています。本研究会では、ワイドギャップ半導体の励起ナノプロセスをテーマとしてとりあげ、種々の観点から最先端の研究を進められている光物性の先生方に招待講演者としてお集まりいただき、基礎から応用にわたる研究の交流の場を提供させていただきます。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

主催：応用物理学会 励起ナノプロセス研究会

日時：2018年1月20日13:00～21日11:45

場所：淡路夢舞台国際会議場(〒656-2306 淡路市夢舞台1番地 <http://www.yumebutai.org/>)

参加費：5,000円

***** プログラム *****

1月20日(土) 13:00～20:00

13:00～13:05 はじめに

保田 英洋 (大阪大学)

13:05～13:50 窒化物半導体量子ドット、単一光子発生とデバイス物理

Mark Holmes (東京大学)

13:50～14:35 ワイドギャップ半導体の発光量子効率と発光寿命の相関

小島 一信、秩父 重英 (東北大学)

14:35～15:20 化合物半導体電子状態の混晶化による変容

篠塚 雄三 (和歌山大学)

15:20～15:45 休憩

15:45～16:30 発光・光音響同時計測による窒化物半導体の内部量子効率測定

山口 敦史、清水 奈緒人、高橋 佑知、小林 玄季、中納 隆、坂井 繁太 (金沢工業大学)、
蟹谷 裕也、富谷 茂隆 (ソニー(株))

16:30～17:15 ワイドギャップ半導体キャリア・フォノンダイナミクス

石谷 善博 (千葉大学)

17:15～18:00 レーザー散乱を用いた InGaN 成長のその場観察

本田 善央 (名古屋大学)

18:00～18:30 休憩

18:30～20:00 意見交換会・運営委員会

1月21日(日) 9:00～11:45

09:00～09:45 励起子と表面プラズモンの結合による高効率発光

岡本 晃一 (九州大学)

09:45～10:30 多光子励起フォトルミネッセンスによるワイドギャップ半導体の三次元イメージング

谷川 智之、松岡 隆志 (東北大学)

10:30～10:55 休憩

10:55～11:40 深紫外域レーザ分光による AlGaIn 混晶半導体の励起子光物性評価

山田 陽一 (山口大学)

11:40～11:45 おわりに

金崎 順一 (大阪大学)

【参加申し込み】

- ・氏名、所属、メールアドレスと2018年1月20日の宿泊の有無を記入の上、金崎 (kanasaki@sanken.osaka-u.ac.jp) 宛に、2017年12月20日までにお申し込み下さい。
- ・宿泊を希望された方には、会場の「ウェスティンホテル淡路」の客室をこちらで予約いたしますが、宿泊費は、当日、ホテルに各自でお支払いください。
- ・参加費は、会場受付で集金いたします。

【連絡先】

大阪大学 超高压電子顕微鏡センター 保田 英洋 Tel:06-6879-7941、E-mail: yasuda@uhvem.osaka-u.ac.jp

大阪大学 産業科学研究所 金崎 順一 Tel:06-6879-8491、E-mail: kanasaki@sanken.osaka-u.ac.jp